FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)					電気的特性 (Ta=25°C)												外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO}最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルスh_{FE} V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)		
1	2	3	4	5					6		7		8						9	10	11	12

1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

: とコンプリ : COMPLEMENTARY TO ·····

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD837	松下	PA	Si.EP	60	5	4 A	40W (Tc=25°C)	150	200	60	1000～10000	3	3 A			t_{on}=0.3μS, t_{off}=4μS							268	ダーリントン
〃 838	三洋	SW	Si.T	2500	6	3 A	50W (Tc=25°C)	150	50	1000	3～15	10	1.5A			t_f< 1 μS							102	水平偏向用
★ 〃 839	三菱	〃	Si.EP	35	20	4 A	30W (Tc=25°C)	150	10	30	1000～3000	5	500			t_r= 3 μS, t_f=1.7 μS t_{stg}= 2 μS							301B	ダーリントン
★ 〃 840	〃	〃	〃	70	20	5 A	40W (Tc=25°C)	150	10	60	1000～3000	5	500			t_r=1.5 μS, t_f=1.5 μS t_{stg}= 4 μS				27 *			301B	ダーリントン
〃 841	東芝	〃	Si.T	800	5	3 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	800	20	5	500	10	−100	t_{on}< 1 μS, t_f< 1 μS t_{stg}< 7 μS				4 *	75		268	
〃 842																								
〃 843	東芝	PA.SW	Si.T	100	5	7 A	40W (Tc=25°C)	150	5	100	70～240	1	1 A	4	−1A	t_{on}=0.4μS, t_f=0.5μS t_{stg}=2.5μS				10 *	250		268	2SB753 とコンプリ
〃 844	〃	PA	〃	50	5	7 A	60W (Tc=25°C)	150	10	50	70～240	1	1 A	5	−1A					15 *	250		179	2SB754 とコンプリ
〃 845	〃	〃	〃	150	5	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	150	100	5	1 A								200		125	
〃 846																								
〃 847	富士電機	SW.PA	Si.TP	40	5	15A	80W (Tc=25°C)	150	10	40	>40	2	5 A			t_{on}= 1 μS, t_f= 1 μS t_{stg}= 2 μS							220	2SB757 とコンプリ
〃 848	日電	PA	Si.T	120	5	7 A	80W (Tc=25°C)	150	50	110	80	5	1 A										295	
〃 849	松下	SW	Si.TMe	1500	5	3 A	70W (Tc=25°C)	150	100	750	7	10	3 A			t_{stg}<16μS, t_f< 1 μS							102	
〃 850	〃	〃	〃	1500	5	3 A	65W (Tc=25°C)	150	50	750	8	10	2.5A			t_{stg}<16μS, t_f< 1 μS							102	
〃 851	日電	PA.SW	Si.E	150	8	10A	80W (Tc=25°C)	150	10	100	3000	2	10A			t_{on}= 1 μS, t_f= 1 μS t_{stg}= 2 μS							340	ダーリントン
〃 852	〃	〃	〃	150	8	15A	100W (Tc=25°C)	150	10	100	3000	2	15A			t_{on}= 1 μS, t_f= 1 μS t_{stg}= 3 μS							340	ダーリントン
〃 853																								
〃 854	三菱	PA	Si.EP	100	5	2.2A	10W (Tc=25°C)	150	0.5	50	100	5	1 A	5	−500	t_{on}<100nS t_{off}<500nS				100 *	30		84B	
〃 855	松下	〃	Si.TP	60	5	1 A	30W (Tc=25°C)	150	200	60	120	4	200										268	
〃 856	〃	〃	〃	60	5	3 A	35W (Tc=25°C)	150	200	60	100	4	1 A										268	
〃 857	〃	〃	〃	60	5	4 A	40W (Tc=25°C)	150	400	60	100	4	1 A										268	
〃 858	〃	〃	〃	60	5	5 A	60W (Tc=25°C)	150	400	60	120	4	1 A										152	
〃 859	〃	〃	〃	350	5	750	35W (Tc=25°C)	150	1 mA	350	120	10	300										268	
〃 860	〃	〃	〃	350	5	1 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	350	120	10	300										268	
★ 〃 861	〃	〃	〃	350	5	1.5A	45W (Tc=25°C)	150	1 mA	350	120	10	300										268	
〃 862	日電	〃	Si.E	20	6	2 A	10W (Tc=25°C)	150	0.1	16	300	2	100										225	
〃 863	三洋	AF.PA	Si.EP	60	5	1 A	900	150	1	50	60～320	2	50	10	−50					150 *	12		294	2SB764 とコンプリ
〃 864	日立	PA.SW	Si.TP	120	7	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	120	1000～20000	3	1.5A			t_{on}=0.5 μS, t_f=1.1 μS t_{stg}=4.5 μS							268	ダーリントン
〃 865	富士電機	SW	〃	300	6	4 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	300	1500	2	3 A			t_{on}< 2 μS, t_f< 5 μS t_{stg}<15 μS							322	ダーリントン
〃 866	松下	〃	Si.EP	130	7	7 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	60～260	2	3 A	10	−500		t_f=0.1μS			30 *			268	